Betriebsbereich  $V_{\rm GS}$   $V_{\rm DS}$   $I_{\rm D}$  Sperrbereich  $>V_{\rm TH}$  beliebig 0

Tabelle 20.3 Strom-Spannungs-Beziehungen für den p-Kanal-MOSFET

Sättigungsbereich  $\langle V_{\rm TH} \rangle \langle V_{\rm GS} - V_{\rm TH} \rangle$ 

Sperrbereich 
$$> V_{\rm TH}$$
 beliebig 0
Widerstandsbereich  $< V_{\rm TH}$   $> V_{\rm GS} - V_{\rm TH}$   $-\beta_{\rm p} \left( V_{\rm GS} - V_{\rm TH} - \frac{V_{\rm DS}}{2} \right) V_{\rm DS}$ 

 $-\frac{\beta_{\rm p}}{2} \left(V_{\rm GS} - V_{\rm TH}\right)^2$